

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 1月22日(金) 10:00~17:15

会場 東京大学山上会館

議題 配線・実装技術と関連材料技術

1. [招待講演] 400万個のマイクロバンプ接続を有する1600画素3次元積層型イメージセンサの信頼性試験結果
○竹本良章・高澤直裕・月村光宏・齊藤晴久・近藤 亨・加藤秀樹・青木 潤・小林賢司・鈴木俊介・五味祐一・松田成介・只木芳隆(オリンパス)
2. [招待講演] 常温12年応力変動の結果から、銅配線のStress Migrationメカニズムの再考
○松山英也(ソシオネクスト)・鈴木貴志・中村友二(富士通研)・塩津基樹・江原英郎(三重富士通)
3. Copper Thin Film Growth using Cu (I) Amidinate Precursor in Supercritical Carbon Dioxide
○Md Rasadujjaman・Mitsuhiro Watanabe (Univ. Yamanashi)・Hiroshi Sudoh・Hideaki Machida (Gas phase growth)・Eiichi Kondoh (Univ. Yamanashi)
4. BTA-H₂O₂ 溶液中におけるCu表面のその場エリプソメトリ
○川上達也・近藤英一・渡邊満洋(山梨大)・濱田聡美・嶋 昇平・檜山浩國(荏原製作所)

午後

5. [招待講演] 低温作製された窒化物薄膜の特性
○武山真弓・佐藤 勝(北見工大)・中田義弘・小林靖志・中村友二(富士通研)・野矢 厚(北見工大)
6. ラジカル処理を用いた低温TiNx膜の特性評価 ○佐藤 勝・武山真弓・野矢 厚(北見工大)
7. PVD-Co(W) single barrier/liner for highly reliable ULSI Cu interconnects
○Taewoong Kim・Kouta Tomita・Takeshi Momose (Univ. of Tokyo)・Takaaki Tsunoda・Takayuki Moriwaki・Takashi Nakagawa (CANON ANELVA)・Yukihiro Shimogaki (Univ. of Tokyo)
8. Fabrication of Multilayer Graphene by Solid-Phase Precipitation with Current Stress
○OMD Sahab Uddin・Hiroyasu Ichikawa・Shota Sano (SIT)・Kazuyoshi Ueno (SIT/RCGI)
9. [招待講演] バンプレスインターコネクトを用いた三次元積層DRAM向けのウエハ薄化評価結果
○Y.S. Kim・S. Kodama・Y. Mizushima・T. Nakamura・N. Maeda・K. Fujimoto(東工大)・A. Kawa(ディスコ)・T. Ohba(東工大)
10. [招待講演] Novel reconfigured wafer-to-wafer (W2W) hybrid bonding technology using ultra-high density nano-Cu filaments for exascale 2.5D/3D integration ○李 康旭・福島崇史・田中 徹・小柳光正(東北大)
11. [招待講演] 2.5D/3D TSV用実装材料技術
○満倉一行・牧野竜也・畠山恵一(日立化成)・Kenneth June Rebibis・Andy Miller・Eric Beyne (IMEC)
12. [招待講演] 印刷によるTSV形成技術の開発—ナノ・ファンクション材料技術の展開—
○池田博明・関根重信・木村竜司・下川耕一・岡田圭二・進藤広明・大井達也・玉木玲衣(ナプラ)・永田 真(神戸大)

◆応用物理学会共催

☆SDM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

1月28日(木) 機械振興会館 [未定] テーマ:先端CMOSデバイス・プロセス技術 (IEDM特集)

3月3日(木), 4日(金) 北大百年記念会館 [未定] テーマ:機能ナノデバイス及び関連技術

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp